水素結合ユニット型有機伝導体β'-[H₃(Cat-EDO-TTF)₂]X (X = BF₄, ClO₄, PF₆, AsF₆)の対アニオン変化に対する系統的な構造物性評価

(東大物性研¹、総合科学研究機構²、KEK 物構研 $PF/CMRC^3$) ○吉田順哉¹、上田 顕¹、中尾朗子²、熊井玲児³、中尾裕則³、村上洋一³、森 初果¹

Systematic Study on Structure and Physical Properties of Hydrogen-bonded-unit-type Organic Conductors β' -[H₃(Cat-EDO-TTF)₂]X $(X = BF_4, ClO_4, PF_6, AsF_6)$ in terms of the Counter Anion (The University of Tokyo¹, CROSS², KEK³) \bigcirc Junya Yoshida¹, Akira Ueda¹, Akiko Nakao², Reiji Kumai³, Hironori Nakao³, Youichi Murakami³, Hatsumi Mori¹

【序論】近年、電子物性と水素結合相互作用が相関した分子性物質の合成とその物性開 拓に注目が集まっている[1-4]。我々はこれまでに、TTF (テトラチアフルバレン) 骨格に

カテコールが直接縮環した電子ドナー分 子 Cat-TTF のエチレンジチオ(-SCH₂CH₂S-)体 H₂Cat-EDT-TTF を用い、 図 1a に示すような水素結合により連結 された TTF 分子ユニットのみから構成さ れる水素結合ユニット型有機伝導体 κ-H₃(Cat-EDT-TTF)₂の合成に成功した[2]。 この水素結合ユニットは、カテコール部 位の脱プロトン化により水素結合部が-1 価を有し、それぞれの TTF 部位が+0.5 価 に酸化されることで全体として中性の開 殻状態となっている。一方、最近合成に 成功したエチレンジオキシ(- 図1. a. H₃(Cat-EDT-TTF)₂, b. [H₃(Cat-EDO-TTF)₂]X OCH₂CH₂O-)体H₂Cat-EDO-TTFをドナ ーとして用いた伝導体 β' -[H₃(Cat-EDO-TTF)₂]BF₄ (\boxtimes 1b, X = BF₄) は、EDT 体とは異なり+1 価の TTF 骨格からなる水素結合ユニット構 造と BF₄-アニオンから構成されている。 室温下でのドナー配列はβ'型で、κ型の EDT 体とは異なっており、さらに図 2 α)を伴った構造相転移を起こすことが 温相 (α型) 明らかとなった ($T_{c} = 210 \sim 230$ K)。



(X = BF₄, ClO₄, PF₆, AsF₆) における水素結合ユニッ トの化学構造と電荷状態



に示したようなドナー配列変化 (β'→ 図 2. [H₃(Cat-EDO-TTF)₂]BF₄の高温相 (β'型) と低

そこで今回、このような特異なユニット構造および構造相転移を有する水素結合型有 機伝導体についてさらに理解を深めるため、β'-[H₃(Cat-EDO-TTF)₂]BF₄の対アニオンを ClO₄, PF₆, AsF₆に置換した類縁体結晶を合成し、対アニオンの違いが構造や物性にどの ような影響を与えるのかを調査したので報告する。

【実験】文献 [1] を基に合成した H₂Cat-EDO-TTF をクロロベンゼンと少量のエタノール に溶解させ、n-Bu₄NX (X = BF₄, ClO₄, PF₆, AsF₆) を支持電解質として電解酸化することに よって[H₃(Cat-EDO-TTF)₂]X (X = ClO₄, PF₆, AsF₆) を得た。単結晶 X 線構造解析、伝導度 及び磁化率測定を行い、これらの構造と物性を比較・考察した。

【結果と考察】X線構造解析の結果、全ての結晶は270Kにおいて同型であり、図 lbの ようなユニット構造を有し、図 2 左のような β ¹型のドナー配列をとっていることが分かっ た。次いで、電気抵抗率測定を行ったところ、BF4, ClO4, PF6, AsF6 とアニオンサイズが大 きくなるにつれて室温抵抗率($\rho_{R,T}$)は増加し(表1)、さらに、今回合成した3種類の塩で は、BF4塩で見られた構造相転移に由来する抵抗率の異常が150Kまで観測されなかった。

	BF4 (高温相)	ClO ₄	PF_6	AsF ₆
<i>a /</i> Å	7.2409(3)	7.2808(4)	7.2482(2)	7.255(3)
<i>b</i> / Å	9.7683(5)	9.8586(8)	10.2680(3)	10.525(4)
<i>c</i> / Å	10.8941(7)	10.8660(8)	10.8587(7)	10.864(4)
$V/\text{\AA}^3$	694.75(7)	701.15(9)	722.24(6)	736.8(5)
$\rho_{\rm RT}$ / ohm cm	50	100	1500	1700

表 1. 旧	H3(Cat-EDO·	$TTF)_2 X(X = BF_2) $. ClO4. PF6. As	F6) における	格子定数と室温抵抗率
--------	-------------	-----------------------	-----------------	----------	------------

そこで、このような物性の違いについて考察するため、 これらの伝導体の結晶構造を比較した。表1に示すよう に、アニオンサイズの増加(BF₄ < ClO₄ < PF₆ < AsF₆)に 伴い、セル体積は連続的に増大し、a, c軸がほぼ一定で あるのに対して、b軸は系統的に伸長していることが分 かった。b軸方向には伝導層内のドナー①②の間のS…S 近接(図3)や、bc面上で隣り合う水素結合ユニット間 のC-H…O近接、ドナー・アニオン間の近接など多様な 相互作用が存在している。実際、b軸の伸長に伴いドナ



図 3.β'型伝導層

一①②間の S…S 距離の増加、重なり積分の減少がみられ、アニオン変化に伴う分子間相 互作用の減少が抵抗率の増加を招いたと考えられる。また、BF4塩のみ、水素結合ユニッ トが平面構造から水素結合部で屈曲して、ドナー配列変化を伴いながら、より強く二量 化しての高抵抗の非磁性相へ転移する。この場合、二量体間の相互作用(①②間)が、 協同的な相転移に効いていると考えられる。

【参考文献】

- [1] Kamo, H.; Ueda, A.; Isono, T.; Takahashi, K.; Mori, H. Tetrahedron Lett. 2012, 53, 4385.
- [2] Isono, T.; Kamo, H.; Ueda, A.; Takahashi, Mori, et al., H. Nat. Commun. 2013, 4, 1344.
- [3] Fourmigué, M.; Batail, P. Chem. Rev. 2004, 104, 5379.
- [4] Morita, Y.; Murata, T.; Nakasuji, K. Bull. Chem. Soc. Jpn. 2013, 197, 183.